How2AppNote 010 eGaN®技術

マルチフェーズ・バックのEPC9130で、48 V入 力、12 V、60 A出力のDC-DCコンバータにおける 最高クラスの性能を実現



動機

単相バック(降圧型)・コンバータは、最大25 A の出力電流で高効率 に動作しますが、より大きな電流では電力効率が大幅に低下します。 マルチフェーズ構成にしてEPC2045などのeGaN®FETを採用すること で、大電力のコンピューティングや電気通信のアプリケーションに適 した小型で費用対効果の高い大電力、高効率の48 V 入力、12 V 出力 のバック・コンバータを実現できます。完全に安定化された非絶縁型 の5相同期整流バック・コンバータとして構成されたEPC9130は、電 力密度が約1000 W/立方インチ、ピーク効率96.2%が得られ、最大 60 A (720 W) の出力を供給することができます。

48 V 入力、12 V 出力の安定化した5相中間バス・コンバー タEPC9130

開発基板のEPC9130は、マイクロコントローラとゲート駆動回 路を基板上に搭載したスイッチング周波数500 kHz、公称入 力電圧48 V、最大出力電流60 A の5相の中間バス・コンバー タ (IBC:intermediate bus converter) で、100 V のエンハンスメン ト・モード (eGaN®) 電界効果トランジスタ (FET) のEPC2045を搭載 しています。この開発基板の目的は、eGaN®FETであるEPC2045の 優れた特性を実証するために、大電力、高性能のアプリケーション 向けに、安定化された12 V の電源電圧を供給することです。この回 路ブロック図が図1です。

開発基板EPC9130は、台湾uPI Semiconductorのゲート・ドライ バUP1966Aや、電源回路、バイパス・コンデンサを備え、ハーフブ リッジ構成の2個のeGaN®FET (EPC2045) を5相搭載しています。 図2は1つの単相パワー段です。ゲート・ドライバへのPWM (パルス 幅変調) 信号は、基板に搭載した米マイクロチップ・テクノロジー のマイクロコントローラdsPIC33によって供給されます。出力電圧 は12 Vに安定化されています。出力の基本電圧モード制御は、マイ クロコントローラが行ないます。相の間の電流の分割、低電圧ロ ックアウト(UVLO)、過電流、過電圧、過熱保護の各機能を利用 可能です。この開発基板では、より柔軟な動作を可能にするため に、電流分割と低電圧ロックアウトのみが実装されています。

実験によるEPC9130の特性検証

出力電流50Aで動作するEPC9130の損失の内訳が図3(左図)で す。

図3 (右図) に

示す最大

FET

温度は、

50 A、

エアフロー

400 LFM の下で、86.1℃です。図4に、500 kHzで動作する場合の最大60 Aま での負荷に対する効率曲線を示します。40 A 負荷でのピーク効率は 96.2%です。

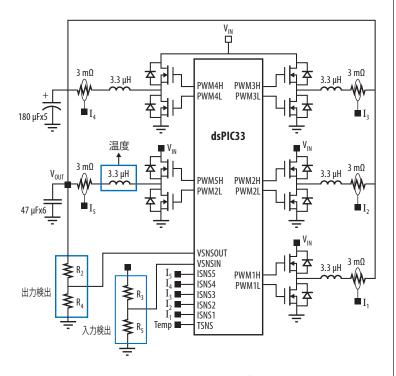


図1:開発基板EPC9130の回路ブロック図

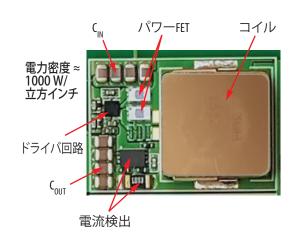


図2:単相パワー段

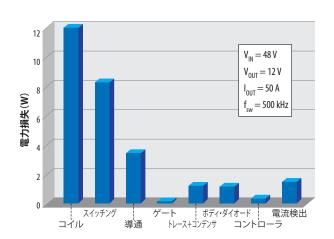
eGaN®技術 How2AppNote 010

結論

48 V 入力、12 V 出力の大電力中間バス・コンバータの設計におい て、シリコンMOSFETからeGaN®FETに移行することによって、効率の 目標を維持、または上回ると同時に、サイズとコストの両方を削減で きます。表1は、1W当たりのコストが0.04米ドル以下になるBOM(部 品表)を示しています。

EPC9130に適したコントローラには、マイクロチップ・テクノロジーの dsPIC33EP128GS704などがあり、これは、補完的なPWM信号の対 を5つ生成することができます。

eGaN®FETベースの48 V入力、12 V、60 A出力のコンバータは、全体で 1 W当たりのコストが0.04ドル以下で、電力密度1000 W/立方インチ、 ピーク効率96.2%を実現できることが実証されました。この同じ部品 表は、5Vの低い出力電圧にも使えます。



48 V入力、12 V、60 A出力の5相バック・コンバータ

部品	数量	eGaN FET
eGaN® FET	10	EPC2045
コイル (3.3 μH)	5	IHLP5050EZER3R3M01
入力コンデンサ (1 µF 100 V)	20	C2012X7S2A105M125AB
出力コンデンサ (22 µF 25 V)	20	C2012X5R1E226M125AC
バルク・コンデンサ (180 μF 16 V)	3	16SVPF180M
ゲート・ドライバ	5	uP1966A
コントローラ	1	DSPIC33EP128GS704-E/ML
合計		1 W当たり0.04米ドル以下

表1:eGaN FET ベースの48 V入力、 12 V出力の5相における各相の部品表(BOM)

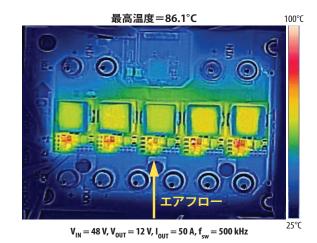


図3:出力電流50 AでのEPC9130の損失の内訳と熱特性

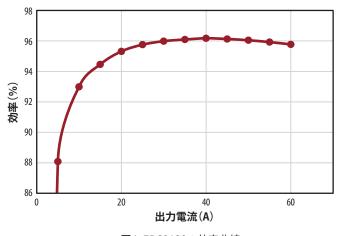


図4:EPC9130の効率曲線



詳細については、

info@epc-co. comに電子メールで、またはお近く の販売代理店にお尋ねください EPCのウェブサイト: epc-co. com/epc/jp/

bit.ly/EPCupdates に登録、または22828に「EPC」とテ キスティングすれば、EPCの最新情報を受信できます











eGaNは、Efficient Power Conversion Corporation, Inc.の登録商標です